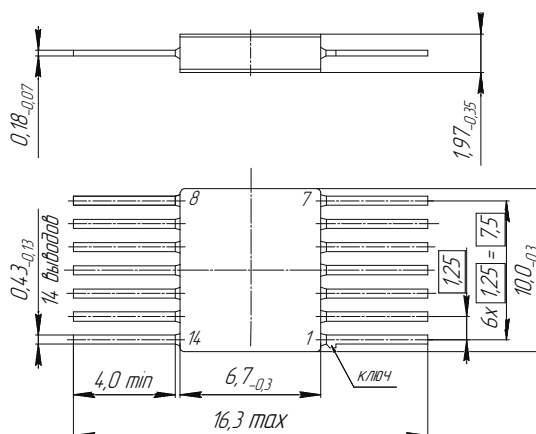
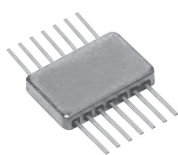


2T693AC

АЕР.432140.064 ТУ

Транзисторная матрица, состоящая из четырех согласованных диэлектрически изолированных и электрически развязанных кремниевых планарных n-p-n транзисторов.

Вторичные источники электропитания,
работающие на частоте 50-100 кГц,
в качестве коммутаторов
и согласованных по параметрам
транзисторов
в радиоэлектронной аппаратуре
специального назначения.
T_{экспл.} : - 60°C ... +125°C



1, 7, 8, 14 — Коллектор
2, 6, 9, 13 — База
3, 5, 10, 12 — Эмиттер
4, 11 — Экран

Металлостеклянный корпус 401.14-5М

Наименование параметра, единица измерения (режим измерения при $T_{\text{окр. ср.}} = +25^{\circ}\text{C}$)	Буквенное обозначение параметра	Значение параметров	
		не менее	не более
Статический коэффициент передачи тока ($I_K = 150 \text{ мА}$, $U_{KЭ} = 5 \text{ В}$)	$h_{21э}$	40	–
Обратный ток коллектор-эмиттер, мкА ($U_{KЭ} = 150 \text{ В}$, $R_{БЭ} \leq 3 \text{ кОм}$)	$I_{КЭР}$	–	10
Обратный ток эмиттера, мкА ($U_{ЭБ} = 5 \text{ В}$)	$I_{ЭБО}$	–	10
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В ($I_K = 150 \text{ мА}$, $I_B = 15 \text{ мА}$)	$U_{KЭ \text{ нас}}$	–	0,6
Напряжение насыщения база-эмиттер, В ($I_K = 150 \text{ мА}$, $I_B = 15 \text{ мА}$)	$U_{БЭ \text{ нас}}$	–	1,15
Примечание - нормы на параметры даны для одного транзистора			